

TX4224 产品规格书

(1.2MHZ最大电流 4A 高效率 DCDC 升压IC)

概述

TX4224是一款高效率,高PWM开关频率的DCDC转换器。芯片内置有4A, 0.07ohm功率开关管,可以提供达8V的输出电压。在输入电压3.3V,输出电压5V时,提供2A的输出电流。芯片高达1.2MHz的开关频率实现小的电感和电容,同时提供极好的动态响应。芯片内置有软启动和环路补偿,只需要很少的外部元器件实现开关应力的减小及系统的稳定性。

产品特点

☑2.5V-6V输入电压范围

☑高达4A的开关电流

☑最高输出电压 8V, SW 脚耐压最高可达 12V

☑低导通阻抗,效率高达 93%

☑内置软启动

☑具有迟滞功能的欠压锁定

☑1.2MHz的固定开关频率

☑内置过温保护

☑内置软启动与环路补偿

☑关断电流低至 1微安

☑ SOT23-6 封装

应用领域

☑扩音器、插卡音响等

☑低压音响系统、USB、2.1/2.0 多媒体音响

☑收音机

☑GPS

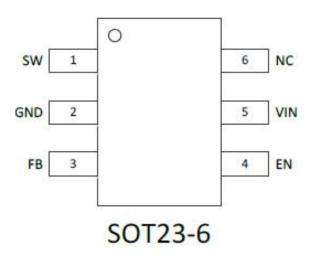
☑K歌宝

☑数码相机

☑平板电脑、手掌游戏机



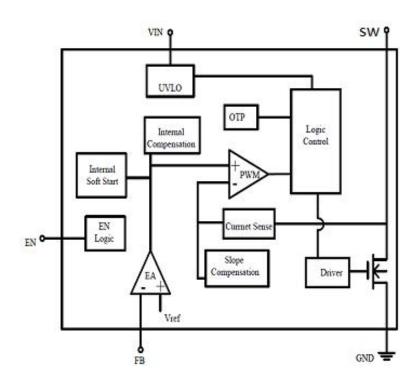
管脚定义



管脚功能描述

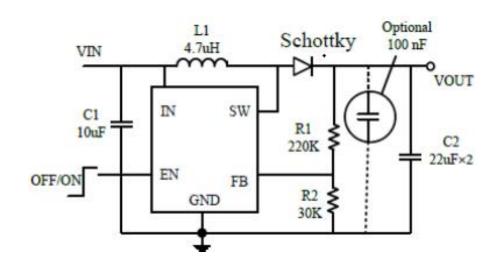
| 管脚号 | 字符 | 管脚描述 |
|-----|-----|---------------------|
| 1 | SW | 开关输出 |
| 2 | GND | 功率地 |
| 3 | FB | 输出电压反馈脚 |
| 4 | EN | 芯片使能信号输 入脚,高电平开启 |
| 5 | VIN | 电源输入 |
| 6 | NC | 空脚,无连接 |

电路框图





原理图



极限应用参数

• TX4224 极限参数表

| 名称 | 描述 | | 参数 | |
|----------------|-----------------------|--------|------------------------------|--|
| VCC | 供出出压 | 升压输入电压 | 2.5V至6.5V | |
| VCC | 供电电压 - | 升压输出电压 | 2.5V至8V | |
| V _I | 输入电压 | | VCC-0.3V至VCC+0.3 | |
| T _A | 环境工作温度 | | -4 0℃至 +8 5℃ | |
| T _J | 结工作温度 | | -4 0℃至 +150 ℃ | |
| T_{stg} | Γ _{stg} 贮藏温度 | | - 65 ℃至+ 1 50℃ | |
| | 焊接温度 | | 240℃, 10S | |

注: 在极限值之外的任何其他条件下, 芯片的工作性能不予保证。



电气特性

| 参数 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--------------|----------------------|-----|------|-----|-----|
| VIN | 输入电压范围 | | 2.5 | | 6 | V |
| Vout | 升压输出范围 | | | | 8 | V |
| Isby | 芯片静态电流 | Vin=3V, No Switching | | 100 | | μA |
| Isd | 芯片关断电流 | Vin=3.7V, EN=0V | | 0.1 | 1 | μΑ |
| VFB | 反馈电压 | | | 0.6 | | V |
| Ilim | 峰值电感电流限 制 | | | 4 | | A |
| Fosc | 振荡器频率 | | | 1.2 | | MHz |
| Rdson | NMOS 导通阻抗 | | | 0.07 | | Ohm |
| VEN | 使能阈值电压 | | 1.5 | | | V |
| OTP | 过温保护点 | | 130 | | | °C |
| Isw | SW 脚漏电流 | | | | 1 | uA |

应用信息

输出电压设定

如典型应用图中所示,输出电压由连接到反馈脚的分压电阻 Rfb1,Rfb2 设定, 反馈脚电压 VFB 为 0.6V, 则输出电压可以设定如下:

$$Vo = (\frac{Rfb1}{Rfb2} + 1) * 0.6$$

较大的 Rfb1,Rfb2 可降低静态功耗,选择合适的 Rfb1,Rfb2 以确保Vo不超过 8V。



功率电感的选择

在确定的 Vin, Vo 情况下, 电感量决定了电感电流的上升斜率及下降斜率。电感电流纹波率 r:

$$r = \frac{\Delta iL}{i_{L-avg}} = \frac{Ro * (1-D)^2 * D}{L * f}$$

其中 Ro 为输出负载等效阻抗, f 为 TX4224 的开关频率。函数 r=f(D) 在 1/3 处有最大值。

在其他条件不变的情况下,电流纹波率 r 与电感量 L 成反比,要保证系统工作在 CCM,必须满足 $r \leq 2$,由此 得到电感的最小值

$$L_{\min} = \frac{Ro * (1 - D)^2 * D}{2 * f}$$

而过小的电感电流纹波率,会导致大的电感量及电感体积,必须确定一个最小纹波率,由此得到电感的最大值 Lmax。

另一方面,大的纹波率导致大的电容电流有效值影响效率,需要在两者间折衷。经验表明 $r=0.3^{\sim}0.5$ 是个 合适的值。在使用小 ESR 电容时,可以增大电流纹波率以减小电感体积。

为避免电感饱和, 电感的额定电流必须大于芯片的过流限制点, TX4224 电流峰值限制典型值为 4A。

推荐使用 2.2uH^{2} 4.7 uH,饱和电流超过 5 A 的功率电感。



电源输入输出电容 Cs 的选择

升压调节器功率开关管的不断开关,会在系统输入端产生纹波,纹波的大小取决于实际应用中电流大小,系统的输入阻抗,及 PCB 布线。必须使用一个输入电容来减小这个纹波,典型条件下 10uF 或则 22uF 已足够,

若输入阻抗较大(例如输入走线很长)时,应加大输入电容值。

锂电池接入电感,并不直接接入芯片引脚,我们暂且称呼电池接入电感端为 VBAT。由于升压电源和功放均从该 VBAT 端获取电流,因此该走线需要尽可能短而粗的走线,以保证走线能承受电流并不至于损耗太大; VBAT 端还需要较大的储能电容,以使 VBAT 电压更加平稳。

推荐使用 220uF 电解电容与 10uF 钽电容并联。尽量靠近电感放置。如应用在输出功率在 5 瓦以下时,为节约成本和 PCB 面积,可仅使用 22uF-47 uF 钽电容即可。

输出二极管的选择

输出二极管的选择取决于输出电压和输出电流。二极管的平均电流等于系统的输出电流,使用的二极管的 额定电流必须大于输出电流,同时二极管上的损耗正比于二极管正向导通压降,应选取正向压降小的二极管。在二极管关断阶段,二极管的反向电压为输出电压,应选取反向耐压大于输出电压的二极管。

视不同应用, 推荐使用 SS32 或更高耐压更大电流的肖特基二极管。



升压输出电容 Cout 的选择

在放大器的应用中,电源的旁路设计很重要,特别是对应用方案的噪声性能及电源电压纹波抑制性能。 TX4224 需要适当的升压输出电容以确保它的高效率和减小输出纹波。升压输出电容采用低阻抗陶瓷电容,尽量靠近输出二极管,因为电路中任何电阻,电容和电感都可能影响到功率转换的效率。一个 220uF 或更大的电解电容放置在输出二极管的附近会得到更好的滤波效果。

推荐使用 220uF 电解电容与 10uF 钽电容并联。

TX4224 内置了过热保护及过压保护等功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。当芯片内部结温超过 130℃,芯片将关断,直到结温低于120℃,芯片重新进入正常工作状态。

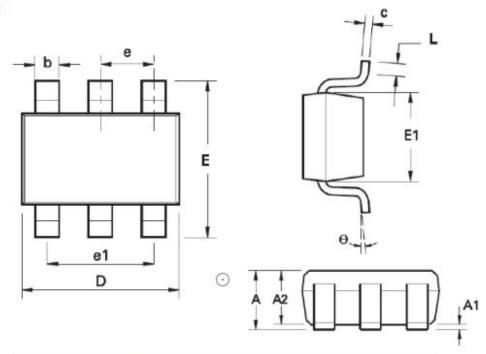
PCB布局建议

- 1: SW脚到电感需要走大电流,电感必须紧靠SW脚,减小高频噪声。同时 SW脚到电感的走线要求宽且短(走线宽度不小于30mi1)。电感底下及周边禁止 走线与覆铜。特别注意模拟地线等容易受干扰的其他线要远离电感。
- 2: 肖特基二极管D1必须靠近电感和SW脚放置,在肖特基二极管负端的输出电容Co必须紧靠二极管D1的负端放置。升压电路的输出给负载以及FB反馈电阻供电时,必须先经过Co电容,禁止使用肖特基二极管负端作为升压输出。



封装信息

SOT23-6



| SYMBOL | | MILLMETER | 2 | | INCHES | |
|----------|----------|-----------|------|-----------|--------|-------|
| STIVIDUL | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX |
| A | ** | | 1.35 | | | 0.053 |
| A1 | 0.04 | | 0.15 | 0.002 | | 0.006 |
| A2 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 0.039 | 0.043 | 0.047 |
| b | 0.34 | ** | 0.43 | 0.013 | | 0.017 |
| С | 0.15 | | 0.21 | 0.006 | | 0.008 |
| D | 2.72 | 2.92 | 3.12 | 0.107 | 0.115 | 0.123 |
| E | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 0.102 | 0.110 | 0.118 |
| E1 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 0.055 | 0.063 | 0.071 |
| e | 0.95 BSC | | | 0.037 BSC | | |
| e1 | 1.90 BSC | | | 0.075 BSC | | |
| L | 0.30 | | 0.60 | 0.012 | | 0.024 |
| θ | 0 | | 8° | 0 | | 8° |



声明

芯鼎盛技术有限公司保留电路及规格书的更改权,以便为客户提供更优 秀的产品,规格若有更改,恕不另行通知。

芯鼎盛技术有限公司一直致力于提高产品质量和可靠性,然而任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效和故障的可能,客户有责任在使用芯鼎盛产品进行产品研发时,应严格按照产品规格书的要求使用芯鼎盛产品,在进行系统设计和和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险造成人身伤害或财产损失等情况。如因客户不当使用芯鼎盛产品而造成的人身伤害或财产损失等情况,芯鼎盛公司不承担任何责任。